附件 3：

国家奖学金申报学生情况简明表

院系名称	集成电路学院	学生姓名	刘昊炎
导师姓名	王文武	学　　号	202118020226005
学科专业	微电子学与固体电子学	攻读学位	博士学位
硕博连读	□ 是　　■否		

在学期间取得的学术成果（须附原件或复印件）

论文：（请按重要性填写 5 篇以内已接收的论文代表作，本人姓名请**标黑并以下划线标注**，论文已接收未发表请标注并在附件中附接收证明）

1. A stacked high-Ge-concentration SiGe/Ge multilayer on a novel Ge + SiGe SRB structure for the gate-all-around MOSFETS；**Haoyan Liu**, Yongliang Li, Xiaohong Cheng , Chun Li , Jiayi Zhang ,Jun Luo 1, Wenwu Wang , and Tianchun Ye；SCI 一作。
2. A Novel SiGe Fin-on-insulator FinFET Device with a SiN Spacer Protection Scheme；**Haoyan Liu**,Chun Li ,Wenwu Wang , Yongliang Li；Ei 一作。
3. A novel narrowed $Si_{0.7}Ge_{0.3}$ channel FinFET device using a precisely controlled digital etching process；**Haoyan Liu**, Yongliang Li；会议一作。

专利：（请按重要性填写申请或授权专利状况，并标注是否被授权，本人姓名请**标黑并以下划线标注**）

1. 刘昊炎，李永亮，殷华湘，罗军，王文武，一种半导体器件及其制造方法；202210634555.6；专利受理。

2. 刘昊炎，李永亮，王晓磊，罗军，王文武，一种半导体器件的制造方法；202211250921.4；专利受理。

……

书籍著作：

无

其他：

在学期间获奖情况（须附原件或复印件）

国科大优秀学生荣誉称号：

1. 2021-2022 年度国科大三好学生

其他获奖情况：

无

在学期间参加公共服务情况

无

学生郑重承诺以上陈述及提交的全部书面材料真实有效。

学生签字：刘昊炎 日期：2022 年 10 月 29 日

注意事项：

1. **表中涉及情况若没有请填写“无”；**
2. **证明材料请按上述填写顺序排列，并将对应序号标注在材料右上角（可铅笔标注）；**
3. **此表请务必双面打印。**

附件 3：

国家奖学金申报学生

情况简明表

院系名称	集成电路学院	学生姓名	陈安澜
导师姓名	李永亮	学　　号	2020E8020282070
学科专业	电子信息	攻读学位	硕士研究生
硕博连读	□ 是　　■否		

在学期间取得的学术成果（须附原件或复印件）

论文：（请按重要性填写 5 篇以内已接收的论文代表作，本人姓名请标黑并以下划线标注，论文已接收未发表请标注并在附件中附接收证明）

1. **A. Chen**, C. Li, Q. Yao, X. Ma, Y. Li, and W. Wang, "Optimization of SiGe interface property with ozone oxidation and stacked HfO_2/Al_2O_3 dielectric for SiGe channel FinFET transistor," Semicond. Sci. Technol., 2022.
   已接收: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6641/ac99f7.

专利：（请按重要性填写申请或授权专利状况，并标注是否被授权，本人姓名请标黑并以下划线标注）

1. 李永亮，**陈安澜**，程晓红，罗军，王文武，一种半导体器件的制造方法，申请日：2022 年 2 月 23 日，申请号：202210167255.1（已受理，还未授权）
2. 李永亮，**陈安澜**，赵飞，程晓红 ，殷华湘，罗军，王文武，一种半导体器件及其制造方法，申请日：2022 年 3 月 25 日，申请号：202210307265.0（已受理，还未授权）
3. 李永亮，**陈安澜**，一种晶体管及半导体器件，申请日：2022 年 8 月 22 日，申请号：202211009051.1（已受理，还未授权）
4. 李永亮，**陈安澜**，一种晶体管及半导体器件的制造方法，申请日：2022 年 8 月 22 日，申请号：202211009056.4（已受理，还未授权）
5. 李永亮，赵飞，**陈安澜**，张佳熠，殷华湘，罗军，王文武，一种半导体器件及其制造方法，申请日：2022 年 3 月 18 日，申请号：202210273113.3（已受理，还未授权）
6. 李永亮，赵飞，**陈安澜**，程晓红，王文武，一种环栅晶体管及其制造方法，申请日：2022 年 5 月 10 日，申请号：202210508772.0（已受理，还未授权）

书籍著作：无

其他：无

在学期间获奖情况（须附原件或复印件）

国科大优秀学生荣誉称号：

1. 2020-2021 年 中国科学院大学三好学生
2. 2021-2022 年 中国科学院大学三好学生标兵

其他获奖情况：

1. 2020-2021 年 中国科学院大学记者团优秀摄影记者
2. 2021 年 微电子所研究生荣誉奖学金——优秀奖
3. 2022 年 中科院微电子所研究生会最佳摄影记者

在学期间参加公共服务情况

1. 国科大集中教学期间担任国科大 UCAS 摄影协会会长，曾多次组织参与校内重大活动的拍摄记录工作（例如 2020 年和 2021 年的国科大新生开学典礼，2020 年的开学第一课，2021 年的国科大毕业典礼）。
2. 回所后加入微电子所研究生会宣传部，负责研究生会各部门举办活动的记录工作和公众号推送文章的编辑。负责的主要活动有 2021 年微电子所芯材奖答辩、2021 年教师节活动、2021 年微电子所寻迹之旅、2021 年中科院十一所联动、2021 年微电子所秋季街拍、2022 年微电子所新春总动员、大家一起读论文、2022 年参观西山无名英雄纪念碑等活动。

学生郑重承诺以上陈述及提交的全部书面材料真实有效。

学生签字：陈安澜 日期：2022 年 10 月 29 日

附件 3：

国家奖学金申报学生

情况简明表

院系名称	集成电路学院	学生姓名	廖明祥
导师姓名	焦建彬	学　　号	2020E8020282006
学科专业	电子信息	攻读学位	硕士
硕博连读	■是　　□否		

在学期间取得的学术成果（须附原件或复印件）

论文：（请按重要性填写 5 篇以内已接收的论文代表作，本人姓名请标黑并以下划线标注，论文已接收未发表请标注并在附件中附接收证明）

1. 《End-to-End Weakly Supervised Object Detection with Sparse Proposal Evolution》 **Mingxiang Liao**, Fang Wan, Yuan Yao, Zhenjun Han, Jialing Zou, Yuze, Bailan Feng, Peng Yuan and Qixiang Ye

专利：（请按重要性填写申请或授权专利状况，并标注是否被授权，本人姓名请标黑并以下划线标注）

1. 《一种点监督的目标检测方法》（已授权） 叶齐祥；廖明祥；万方；焦建彬；韩振军
2. 《一种伪标签框生成方法、装置及电子设备》（实质审查） 万方；邵滨；廖明祥；许松岑；叶齐祥

书籍著作：

无

其他：

在学期间获奖情况（须附原件或复印件）

国科大优秀学生荣誉称号：

1. 三好学生 其他获奖情况： 1. 无
在学期间参加公共服务情况 1. 无
学生郑重承诺以上陈述及提交的全部书面材料真实有效。 学生签字：[illegible] 日期：2022.10.30

注意事项：

1. **表中涉及情况若没有请填写“无”；**
2. **证明材料请按上述填写顺序排列，并将对应序号标注在材料右上角（可铅笔标注）；**
3. **此表请务必双面打印。**